

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成18年3月9日(2006.3.9)

【公表番号】特表2005-519187(P2005-519187A)

【公表日】平成17年6月30日(2005.6.30)

【年通号数】公開・登録公報2005-025

【出願番号】特願2003-568121(P2003-568121)

【国際特許分類】

C 2 3 C	14/04	(2006.01)
C 2 3 C	14/24	(2006.01)
H 0 1 L	21/363	(2006.01)
H 0 1 L	33/00	(2006.01)
H 0 5 B	33/10	(2006.01)
H 0 1 L	51/50	(2006.01)
H 0 1 L	21/336	(2006.01)
H 0 1 L	29/786	(2006.01)
H 0 1 L	51/05	(2006.01)

【F I】

C 2 3 C	14/04	A
C 2 3 C	14/24	G
H 0 1 L	21/363	
H 0 1 L	33/00	A
H 0 5 B	33/10	
H 0 5 B	33/14	A
H 0 1 L	29/78	6 2 7 C
H 0 1 L	29/78	6 1 7 J
H 0 1 L	29/78	6 1 7 V
H 0 1 L	29/78	6 1 8 B
H 0 1 L	29/78	6 1 8 A
H 0 1 L	29/78	6 1 6 K
H 0 1 L	29/28	

【手続補正書】

【提出日】平成18年1月18日(2006.1.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

アパー・チャマスクを堆積基板に近接して配置するステップと、

前記アパー・チャマスクを2以上の自由度を用いて張り広げて前記アパー・チャマスクを前記堆積基板と位置合わせするステップと、

張り広げた前記アパー・チャマスクを介して材料を堆積させて前記堆積基板上に層を形成するステップとを含む方法。

【請求項2】

高分子と磁性材料とを含む高分子アパー・チャマスク。

【請求項3】

可撓性の再配置可能な高分子アーチャマスクを堆積基板に近接して配置するステップと、

前記可撓性アーチャマスクのたるみを制御するステップと、

前記可撓性アーチャマスクを介して材料を堆積させて、前記堆積基板上に集積回路の少なくとも一部分を規定する層を形成するステップとを含む方法。

【請求項4】

第1の側に材料層が形成された高分子フィルムを前記材料層の反対側からアプレートして前記高分子フィルムにパターンを規定するステップであって、前記パターンが前記高分子フィルムにわたって延在する堆積アーチャを規定するステップと、

前記材料を除去して高分子アーチャマスクを形成するステップとを含む方法。

【請求項5】

再配置可能な高分子アーチャマスクを非プレーナ堆積基板の上方に配置するステップと、

前記高分子アーチャマスクを介して前記非プレーナ堆積基板上に材料を堆積することにより前記非プレーナ堆積基板上に集積回路の少なくとも1つの層を形成することを含み、前記集積回路の前記層が薄膜トランジスタの少なくとも一部分を含むことを特徴とする方法。

【請求項6】

高分子フィルムから堆積アーチャのパターンを融除して集積回路製作用の堆積プロセスで使用する再配置可能な高分子アーチャマスクを作製するステップと、

前記融除を制御して前記堆積アーチャの1つ以上の許容側壁角を生じさせるステップとを含む方法。

【請求項7】

堆積アーチャのパターンが形成された高分子マスク基板と、

前記パターンの縁部付近に配設された、前記マスク基板内にある歪み最小化フィーチャ

とを含むアーチャマスク。